◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-274486

⑤Int.Cl.⁴

勿出

願 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月2日

H 01 S 3/096

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

夕発明の名称 半導体レーザ監視装置

②特 願 昭63-104572

②出 願 昭63(1988) 4月27日

⑩発 明 者 手 嶋 善善 昭

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号

⑩代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

松下電送株式会社

明 細 葡

1. 発明の名称

半導体レーザ監視装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、レーザ・ブリンタ、光ディスク装置、

光ピーム通信などに用いられている半導体レーザ およびその周辺回路を監視するための半導体レー ず監視装置に関する。

従来の技術

この板の用途に用いられた半導体レーザは、その光出力レベルを一定に保つように駆動電流が制御される。さらには、特開昭 5 7-1 7 2 7 8 6 号公報などに見られるように、上記駆動電流制御とともに、半導体レーザのケース温度を一定に保つように半導体レーザの加熱または冷却の制御が行われる。

とのような半導体レーザと、その周辺回路(駅 動制御回路、光出力レベルのモニター手段)を監 祝するための装置の従来例を第3図に示す。

I 世半導体レーザ、2 はその光出力レベルLout のモニターのためのフォトダイオードである。 4 はフォトダイオード 2 の検出出力電圧 V L を基準 レベル電圧 V O に保つように半導体レーザ 1 の駅 動電流 Ix を制御するAPC(自動光出力制御)回 路である。とのAPC回路 4 は、基準レベル電圧 VOを発生する基準レベル発生回路 5、フォトダイオード 2 の検出出力電圧 V L と基準レベル電圧 V O の差別増幅 で行う差別増幅 回路 6 、 および 差別増幅 回路 6 の出力 に応じた 駆動電流 Ix を半導体レーザ 1 に供給する駆動電流供給回路 7 から構成されている。

8は監視装置であり、駆動電流 Ix を検出するための電流検出回路 9、基準レベル電圧 V S を発生する回路 10、電流検出回路 9の検出出力電圧 V I と 悲楽レベル電圧 V S とを比較する比較回路 11 より構成されている。比較回路 11 は V I > V S のとき、 すなわち駆動電流 Ix が基準レベル V S に対応したある一定レベルを越えたときに、 異常と判定して監視出力信号 Sout をオンにする。

これは駆動電流制御だけが行われる半導体レーザの監視装置の例であるが、駆動電流制御と温度 制御が行われる半導体レーザの監視装置も同様の 構成であった。

発明が解決しようとする課題

半導体レーザの光出力対駆動電流特性は、第4

止するために駆動電流の範囲を広めに設定する必要があり、検出すべき本来の異常が発生しても、 それを検出して通知できないことがあった。

本発明は、上述の問題点に鑑みてたされたもので、半導レーザの温度変化の影響による監視エラーを防止し、半導体レーザの劣化や周辺回路の故障などによる本来の異常を確実に検出して外部に通知できるようにした半導体レーザ監視装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

図に示すように、劣化の度合いによって大幅に変化する。上述の従来装置は、このような半導体レーザの劣化により発光効率が低下したり、光出力モニタ川フォトダイオードやAPC回路が故障したときに、半導体レーザに過電流が流れることに着目して、異常検出を行っている。

しかし、かかる構成によれば、的確な監視が不可能な場合があった。

前記温度判定手段の判定出力を入力として前記検 出温度が前記温度範囲内のときのみ前記電流判定 手段の判定出力を有効な監視出力として外部に送 出する手段とを有する構成である。

作用

上述のように本発明によれば、半導体レーザのケース温度が一定の温度範囲内であるときのみ駆動電流に関する判定出力が有効な監視出力となり、また、この判定のための電流範囲はケース温度が上記温度範囲内であることを条件として設定される。

したがって、半導体レーザの劣化や周辺回路の 故障などがないにも拘わらず、半導体レーザのケ ース温度が一定の温度範囲を外れたために半導体 レーザの駆励電流が一定範囲から逸脱したときに、 それが誤って異常として外部に通知されることが なくなる。

また、このような監視エラーを心配して駆動電 流の範囲を広めに設定する必要がなく、適切な範 囲に設定することができるため、導体レーザの劣

化や周辺回路の故障などによる本来の異常が発生 したときに、それを確実に外部に通知することが できる。

爽施例

以下本発明の一実施例について、図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例による半導体レーザ 監視装置の概略構成図であって、符号1,2,4 および9はそれぞれ第3図中の対応符号と同一部 を示す。

本実施例においては、半導体レーザ1の駆動電 施制御とともに、半導体レーザ1の温度制御も行われる。この温度制御は、ベルチェ案子などを用いて加熱および冷却の両方により行うこともできるが、本実施例ではヒータ13の発熱を制御することによって温度制御が行われる。14は半導体レーザ1のケース温度を検出する温度センサであり、これはヒータ13と一緒に半導体レーザ1のケース上またはその近くに設けられる。

15杜半導体レーザ1のケース温度を一定に保つ

てある。

19は監視回路であり、これは電流検出回路9、温度センサ14、および温度判定手段としての温度校出回路16とともに半導体レーザ1とその周辺回路を監視するための装置を構成している。この監視回路19は、駆動電流Ixが一定の電流範囲(半導体レーザのケース温度を40で土△2とした条件で設定される)であるか否かを判定するための比較回路20、21およびANDゲート22、この電流範囲の下限レベル電圧VTおよび上限レベル電圧VSを発生する回路23および21、ORゲート25から構成されている。

一方の比較回路20は電流検出回路9の検出出力 電圧VRを下限レベル電圧VTと比較し、VT < VTのときに出力信号をオン(Lレベル)にする。 他方の比較回路21は、駆動電流の検出出力電圧V Rを上限レベル電圧VSと比較し、VR>VSの ときに出力信号をオン(Lレベル)にする。AN Dゲート22は比較回路20,21の出力信号の論理積 信号Cを出力し、ORゲート25はこの論理積信号 ようにヒータ13による加熱を制御する温度制御回路であり、温度検出回路16、ANDゲート17およびスイッチ回路18より成っている。

温度検出回路16は、温度センサ14の検出出力信号を入力とし、その検出温度に応じた通電制御信号Aを出力するものであるが、これは監視技どの温度制定手段でもあり、その判定出力として出力との調査は検出温度(ケース温度)を40で生ム1の範囲によってもり、温度確定信号Bは検出温度が10で生ム2の範囲内のときにオン(Lレベル)になり、この温度範囲を逸脱したときにオークになり、になる信号である。ただし、ム1くム2である。

ANDゲート17は、外部から与えられる検出指令信号Eがオン(Hレベル)のときに通電制御信号Aをスイッチ回路18に入力するためのものであり、スイッチ回路18はANDゲート17からの入力信号(A)に従ってヒータ13の通電路を開閉する回路

C (電流判定出力) と温度確定信号 B の論理和信号を監視出力信号 Sout として出力する。

以上のように構成された半導体レーザ周辺回路 および監視装置について、以下その動作を説明す る。第2図は動作説明の理解を助けるためのタイ ムチャートである。

検出指令信号Eがオンした時にケース温度THは40で一△1より低いので、通電制御信号Aはオン(Hレベル)になり、スイッチ回路18はヒータ13の通電路を閉じてヒータ13に通電させる。ヒータ13の発熱により半導体レーザ1は加熱され、そのケース温度は上昇する。

ケース温度が40℃+△1 に達すると、通電制御信号Aはオフ(Lレベル)になり、スイッチ回路18はヒータ13の通電を断つため、ケース温度は徐々に下がる。ケース温度が40℃-△1まで下がると、通電制御信号Aは再びオンになってヒータ13は再び通電され、半導体レーザ1は加熱される。

とのようにして、半導体レーザ1のケース温度 を低収40℃に保つような温度制御が行われる。 半導体レーザ1のケース温度が40で一へ2以上 に上昇するまでの期間においては、温度確定信号 Bはオフ(Hレベル)である。したがって、この 期間内に駆動電流 Ix が一定範囲から逸脱し判定出 力信号でがオン(レベル)になったとしても、 監視出力信号 Sout はオフ(Hレベル)となる。 すなわち、駆動電流の判定出力は無効にされる。

その後、ケース温度が一定の温度範囲(40で土 へ2)内に安定すると、温度確定信号Bはオン (Lレベル)になるため、ANDゲート22の出力 信号、すなわち駆動電流の判定出力信号Cは有効 な監視出力信号Sout として外部に送出される。 したがって、半導体レーザ1の劣化や、APC回 路4の故障、フォトダイオード13の故障などに自り VR < VTとなるか、あるいは上限値を上回りV R>VSとなり、比較回路20あるいは21の出力信 号がオンになると、監視出力信号Soutはオン (Lレベル)になり、異常の検出が外部に通知されるとになる。

範囲を設定できるため、半導体レーザの劣化や周辺回路の故障による本来の異常が生じたにも拘わらず、それを外部に通知できないといった監視エラーも防止できる。など、半導体レーザおよび周辺回路の確実な監視が可能になるという効果を有するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例による半導体レーザ 監視装置の概略構成図、第2図は同装置の動作脱 明用タイムチャート、第3図は半導体レーザ監視 装置の従来例の概略構成図、第4図は半導体レー ザの光出力対駆動電旋特性を劣化の度合い別に示 す特性線図、第5図は半導体レーザの光出力対駆 動電旋特性を温度別に示す特性線図である。

1 … 半導体レーザ、2 … フォトダイオード、4
… A P C (自動光出力制御) 回路、9 … 電流検出 回路、13 … ヒータ、14 … 温度センサ、15 … 温度制 御回路、16 … 温度検出回路、19 … 監視回路、20,
21 … 比較回路、22 … A N D 回路、25 … O R 回路。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名 なお、温度確定信号Aも温度監視信号として外部に出力してもよい。

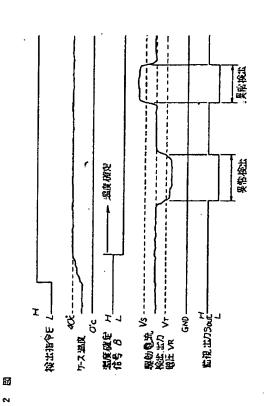
監視回路19や温度検出回路16などの機能をマイクロプロセッサなどを使用してプログラムにより 実現してもよい。

発明の効果

以上の説明から明らかなように、本発明は、半 導体レーザのケース温度が一定の温度範囲内であるときに限り、それを条件として設定した電流 団内の駆動電流が半導体レーザに流れているかか かの判定出力を有効な監視出力として外部に通知 するため、半導体レーザやその周辺回路が正常で あるにも拘わらず、半導体レーザの温度変動の影響により駆動電流が過大または過小となったとき に誤って異常として外部に通知することを防止できる。

そのような監視エラーを心配して駆動電流の範囲を広めに設定する必要がないので、検出すべき 導体レーザの劣化や周辺回路の故障などによる駆動電流の異常検出だけを考慮して適切な幅の電流

郑] 図 避难之74 4 温度制御配路 温度模出 0 舒 動電流 A通電制的信号 B.温度確定信号 検出指令E. VL ARC回路 電流検出 回路 3 Îx 北較回針 下限レベル Sout 監視出力 FEWI ILEXOR C. 电流判定出力 19監視回路



法

